



CM1N60C N 沟道 VDMOS

* 主要用途：

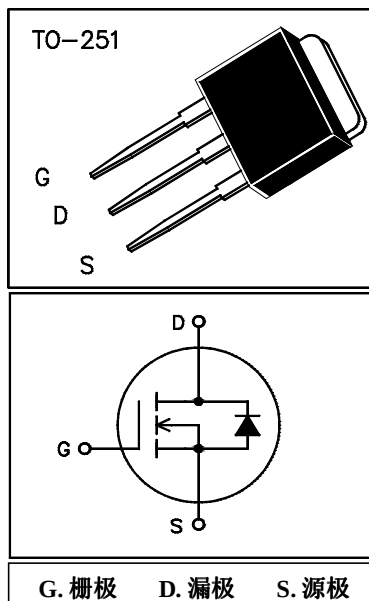
- ◆ 主要用于电源适配器、线性放大和功率开关电路

* 主要特点：

- ◆ 通态电阻小，输入电容小
- ◆ 开关速度快
- ◆ 100% 雪崩能量测试

* 注意：

- ◆ 防静电

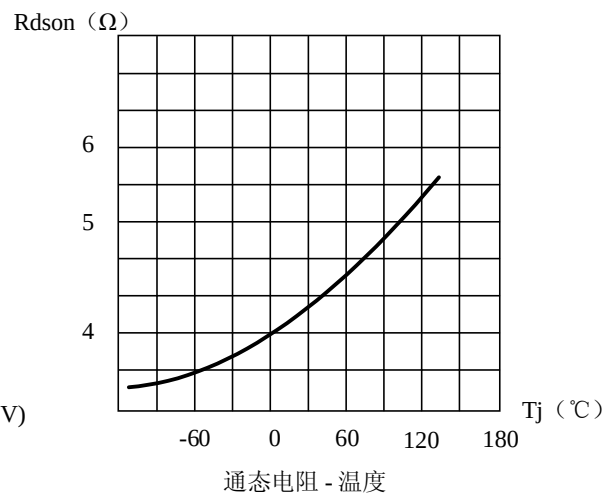
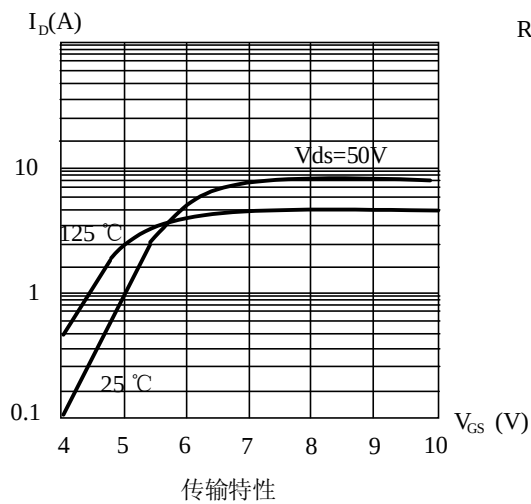
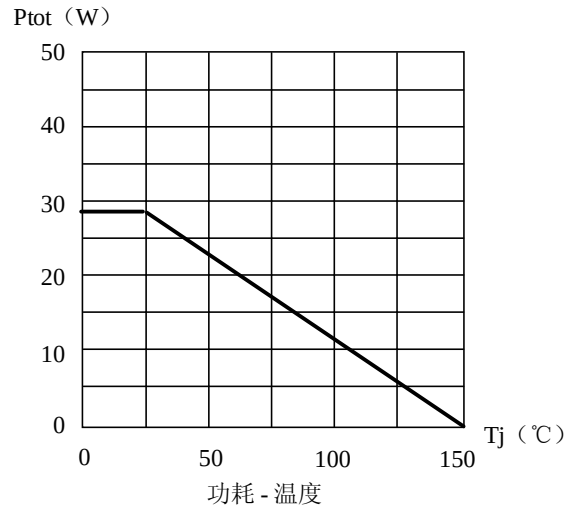
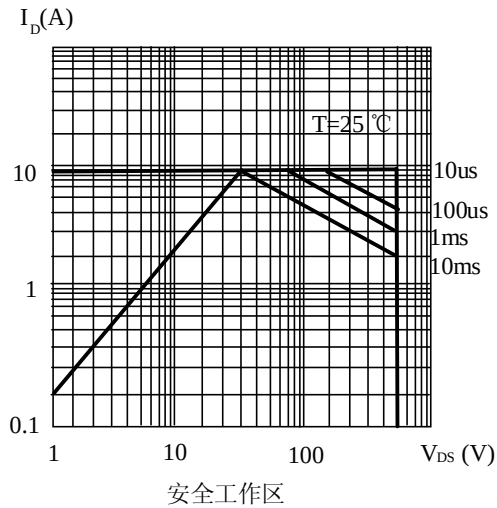
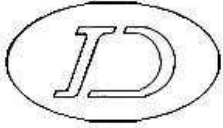


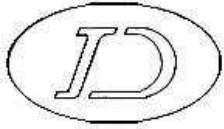
极限值：(Tc=25℃)

参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
连续漏极电流	I_D	1.0	A
栅源电压	V_{GS}	± 30	V
雪崩电流	I_{AR}	1.0	A
热阻（结到壳）	$R_{\theta JC}$	2.5	℃/W
耗散功率	P_{tot}	28	W
结温	T_{jm}	150	℃
贮存温度	T_{stg}	- 55 ~ 150	℃

电特性：(Tc=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源反向电压	V_{DS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600			V
通态电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=0.5A$			12	Ω
阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	2		4	V
跨导	g_{FS}	$V_{DS}=50V, I_D=0.5A$	0.5			S
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$			25	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V$			± 100	nA
关断延迟时间	$t_d(off)$	$V_{DD}=250V, I_D=1.0A$ $R_G=2.15\Omega, R_D=178\Omega$		20		nS
输入电容	C_{iss}	$V_{GS}=0V, V_{DS}=25V$ $f=1.0MHz$		229		pF
a: 脉冲测试： $t_p \leq 300\mu s, \delta \leq 2\%$						





封装形式:

TO-251 (单位: mm, 无其他特别说明公差 $\pm 0.1\text{mm}$)

